

รายการอ้างอิง

- [1] Mondry, M. J., Babic, D. I., Bowers, J. E., and Coldren, L. A. Refractive indexes of (Al,Ga,In)As epilayers on InP for optoelectronic applications. IEEE Photonics Technology Letters 4 (June 1992): 627-630.
- [2] Martin, P., Skouri, E., M., Chusseau, L., Alibert, C., and Bissessur, H. Accurate refractive index measurements of doped and undoped InP by a grating coupling technique. Applied Physics Letter 67 (August 1995): 881-883.
- [3] Gehrsitz, S., Reinhart, F. K., Gourgon, C., Herres, N., Vonlanthen, A., and Sigg, H. The refractive index of $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ below the band gap: Accurate determination and empirical modeling. Journal of Applied Physics 87 (June 2000): 7825-7837.
- [4] Fukuda, M. Optical semiconductor devices. New York: Wiley & Sons Inc., 1999.
- [5] Bhattacharya, P., Semiconductor optoelectronic devices. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
- [6] Peyre, H., Alsina, F., Camassel, J., Pascual, J. and Glew, R. W. Thermal stability of InGaAs/InGaAsP quantum wells. Journal of Applied Physics 73 (April 1993): 3760-3768.
- [7] Gaskill, D. K., Bottka, N., Aina, L. and Mattingly, M. Band-gap determination by photoreflectance of InGaAs and InAlAs lattice matched to InP. Applied Physics Letter 56 (March 1990): 1269-1271.
- [8] Murtaza, S. S., et al. High-finesse resonant-cavity photodetectors with an adjustable resonance frequency. Journal of Lightwave Technology 14 (June 1996): 1081-1089.
- [9] McElhinney, M. and Stanley, C. R. Molecular beam epitaxial growth and thermodynamic analysis of InGaAs and InAlAs lattice matched to InP. Journal of Crystal Growth 150 (May 1995): 518-522.
- [10] Grassi, E., Johnson, S. R., Beaudoin, M. and Tsakalis, K. S. Modeling of optical constants of InGaAs and InAlAs measured by spectroscopic ellipsometry. Journal of Crystal Growth 201-202 (May 1999): 1081-1084.
- [11] Pinsukanjana, P. R., et al. InGaAs composition monitoring for production MBE by in situ optical-based flux monitor (OFM). Journal of Crystal Growth 251, (April 2003): 124-129.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายหัสเนตร์ โสดาบรรณ เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2543 ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2546 เนื่องจากมีความสนใจด้านสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำและเทคโนโลยีทางด้านสิ่งประดิษฐ์ทางแสง จึงได้เลือกทำวิทยานิพนธ์เรื่องการวิเคราะห์แบเรทรีเฟกเตอร์ของสารประกอบเริ่มต้นแกลเลียมอาร์เซไนด์ในย่าน 1.3 ไมโครเมตร



ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย